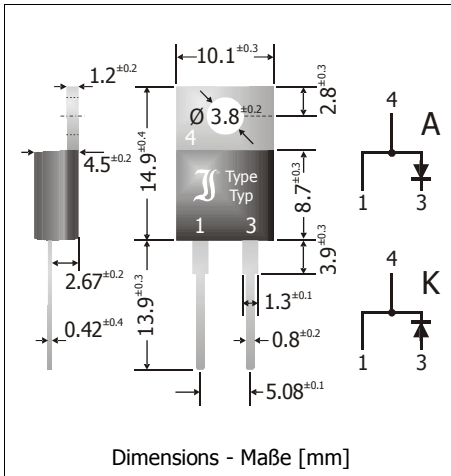


FT2000AA ... FT2000KG

**Superfast Silicon Rectifiers – Single Diode / Two Polarities
Superschnelle Silizium-Gleichrichter – Einzeldiode / Zwei Polaritäten**

Version 2010-03-31



- Nominal current / Nennstrom: 20 A
- Repetitive peak reverse voltage / Periodische Spitzensperrspannung: 50...400 V
- Plastic case / Kunststoffgehäuse: TO-220AC
- Weight approx. / Gewicht ca.: 1.8 g
- Plastic material has UL classification 94V-0 / Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
- Standard packaging in tubes / Standard Lieferform in Stangen



Maximum ratings and Characteristics

Grenz- und Kennwerte

Type / Typ	Repet. peak reverse voltage / Period. Spitzensperrspannung.	Surge peak reverse volt. / Stoßspitzensperrspannung.	Forward voltage / Durchlass-Spannung	
Polarity / Polarität	V_{RRM} [V]	V_{RSM} [V]	V_F [V] ¹⁾	
K (Standard)	A (Reverse)		$I_F = 5 A$	$I_F = 20 A$
FT2000KA	FT2000AA	50	< 0.84	< 0.96
FT2000KB	FT2000AB	100	< 0.84	< 0.96
FT2000KD	FT2000AD	200	< 0.84	< 0.96
FT2000KG	FT2000AG	400	< 0.84	< 0.96

Max. average forward rectified current, R-load / Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 100^\circ C$	I_{FAV}	20 A
Repetitive peak forward current / Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 Hz$	I_{FRM}	80 A ²⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave / Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ C$	I_{FSM}	375/390 A
Rating for fusing, $t < 10 ms$ / Grenzlastintegral, $t < 10 ms$	$T_A = 25^\circ C$	i^2t	680 A ² s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb		T_j	-50...+150°C
		T_j	+200°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	-50...+175°C

1 $T_j = 25^\circ C$

2 Max. temperature of the case $T_C = 100^\circ C$ – Max. Temperatur des Gehäuses $T_C = 100^\circ C$

Characteristics
Kennwerte

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R	< 25 μA
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 0.5 \text{ A}$ through/über $I_R = 1 \text{ A}$ to $I_R = 0.25 \text{ A}$	t_{rr}	< 200 ns
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse		R_{thc}	< 1.5 K/W

